

**Физика и техника полупроводников,  
2020, том 54, выпуск 6**

**Электронные свойства полупроводников**

Сардарлы Р.М., Салманов Ф.Т., Алиева Н.А., Аббаслы Р.М.

**Импедансные характеристики  $\gamma$ -облученных твердых растворов  $(\text{TlGaSe}_2)_{1-x}(\text{TlInS}_2)_x$**  511

Аванесян В.Т., Жаркой А.Б., Ракина А.В.

**Особенности переноса заряда в легированных слоях сульфида цинка в низкочастотном переменном электрическом поле** 519

Нифтиев Н.Н., Мамедов Ф.М., Мурадов М.Б.

**Электропроводность  $\text{FeGaInSe}_4$  на переменном токе** 523

**Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**

Гусейналиев М.Г., Ясинова С.Н., Джалилли Д.Н., Мехтиева С.И.

**Оптические свойства и критические точки наноструктурированных тонких пленок  $\text{PbSe}$**  527

Priya V.L., Prithivikumaran N.

**Influence of Ni-Doping in ZnO Thin Films Coated on Porous Silicon Substrates and ZnO/PS Based Hetero-junction Diodes** 532

**Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Галашев А.Е., Воробьев А.С.

**Электронные свойства пленок силицена, подвергнутых нейтронному легированию** 533

Dubrovskii V.G., Reznik R.R., Kryzhanovskaya N.V., Shtrom I.V., Ubyivovk E.D., Soshnikov I.P., Cirlin G.E.

**MBE-Grown  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  Nanowires with 50% Composition** 542

**Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники**

Амасев Д.В., Михалевич В.Г., Тамеев А.Р., Саитов Ш.Р., Казанский А.Г.

**Формирование двухфазной структуры в металлоорганическом перовските  $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$**  543

**Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**

Шутаев В.А., Гребенщикова Е.А., Сидоров В.Г., Компан М.Е., Яковлев Ю.П.

**Влияние водорода на импеданс структур  $\text{Pd/оксид/InP}$**  547

**Углеродные системы**

Рутьков Е.В., Афанасьева Е.Ю., Галль Н.Р.

**Транспортные процессы с участием атомов углерода между поверхностью и объемом родия при образовании и разрушении графена** 552

**Физика полупроводниковых приборов**

Асадчиков В.Е., Дьячкова И.Г., Золотов Д.А., Чуховский Ф.Н., Никитина Е.В.

**Коррекция характеристик кремниевых фотодиодов путем применения ионной имплантации** 557

Марков Л.К., Смирнова И.П., Кукушкин М.В., Павлюченко А.С.

**Модификация рельефа n-поверхности  $\text{AlGaInN}$ -светодиодов изменением состава газовой смеси при реактивном ионном травлении** 564

Жуков А.Е., Крыжановская Н.В., Моисеев Э.И., Кулагина М.М., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Надточий А.М., Максимов М.В.

**Предельная температура генерации микродисковых лазеров** 570

Калыгина В.М., Алмаев А.В., Новиков В.А., Петрова Ю.С. <b>Солнечно-слепые детекторы УФ-излучения на основе пленок beta-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	575
Калядин А.Е., Штельмах К.Ф., Аруев П.Н., Забродский В.В., Карабешкин К.В., Шек Е.И., Соболев Н.А. <b>Кремниевые светодиоды с люминесценцией (113) дефектов</b>	580
<b>Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур</b>	
Laifi J., Bchetnia A. <b>Impact of Carrier Gas on the GaN Layers Properties Grown on (001) and (11n) GaAs Substrates by AP-MOVPE: Comparative Study</b>	585
Mahmoodnia H., Salehi A., Mastelaro V.R. <b>GaAs Semiconductor Passivated by (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>x</sub>: Analysis of Different Passivation Methods by Electrical Characteristics and XPS Measurements</b>	586